

## МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

**Федоров М.М., проф., д.т.н.; Казак А.О., студент; Кузнецов Г.В., студент**  
(ГУВЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, Украина)

Анализ режимов работы в системах автоматического управления сопровождается необходимостью расчета переходных процессов. Важным элементом является оценка длительности протекания переходного процесса, которую можно оценить путем решения характеристического уравнения системы дифференциальных уравнений описывающих процессы в соответствующей системе автоматического управления.

Рассмотрим алгоритм составления характеристического уравнения на примере схемы приведенной на рис.1.

В схеме имеется источники напряжения и тока, два реактивных разнородных элемента индуктивность  $L_3$  и емкость  $C_2$ .

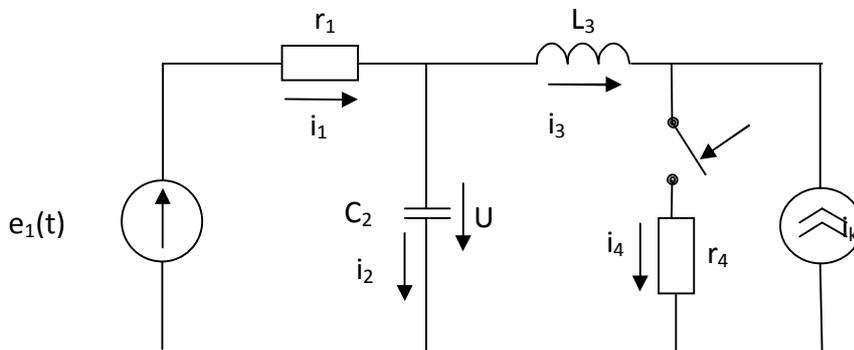


Рисунок 1- Электрическая схема

Составляем уравнения по законам Киргофа:

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_3 = 0 \\ i_3 - i_4 = -i_k \\ i_1 r_1 + \frac{1}{C} \int i_2 dt = e_1(t) \\ i_1 r + L \frac{di_3}{dt} + i_4 r_4 = e_1(t) \end{cases} \quad (1)$$

Запишем систему ДУ для свободной составляющей.

Свободная составляющая не зависит от внешних сил, то есть в уравнениях отсутствуют источники напряжения и тока, система примет вид:

$$\begin{cases} i_{1\text{св}} - i_{2\text{св}} - i_{3\text{св}} = 0 \\ i_{3\text{св}} - i_{4\text{св}} = 0 \\ i_{1\text{св}} r_1 + \frac{1}{C} \int i_{2\text{св}} dt = 0 \\ i_{1\text{св}} r + L \frac{di_{3\text{св}}}{dt} + i_{4\text{св}} r_4 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Ток в  $k$ -ой ветви свободной составляющей в общем случае равен:

$$i_{k_{ce}} = A_k e^{pt} \quad (3)$$

Где  $A_k$  - постоянная интегрирования,  $p$ -корень характеристического уравнения, тогда свободная составляющая напряжения на индуктивном элементе равна:

$$u_{L_{ce}} = L \frac{di_{3_{ce}}}{dt} = Lp \cdot A_3 e^{pt} = Lp \cdot i_{3_{ce}} \quad (4)$$

напряжение на емкостном элементе соответственно равно:

$$u_{C_{ce}} = \frac{1}{C} \int i_{2_{ce}} dt = \frac{1}{C} \int A_2 e^{pt} dt = \frac{1}{Cp} A_2 e^{pt} = \frac{1}{Cp} \cdot i_{2_{ce}} \quad (5)$$

С учетом выше изложенного, система уравнений для свободной составляющей примет вид:

$$\begin{cases} i_{1_{ce}} - i_{2_{ce}} - i_{3_{ce}} + 0 = 0 \\ 0 + 0 + i_{3_{ce}} - i_{4_{ce}} = 0 \\ i_{1_{ce}} r_1 + \frac{1}{Cp} i_{2_{ce}} + 0 + 0 = 0 \\ i_{1_{ce}} r + 0 + Lp i_{3_{ce}} + i_{4_{ce}} r_4 = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Полученной системе уравнений соответствует схема приведенная на рис.2.

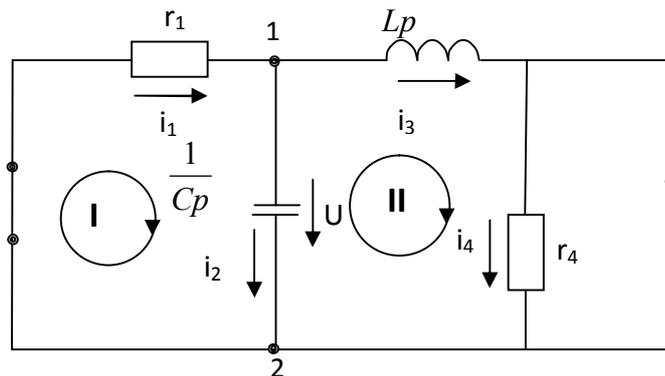


Рисунок 2 –Электрическая схема для свободной составляющей

Из полученной системы уравнений следует что, определитель системы равен:

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ r_1 & \frac{1}{Cp} & 0 & 0 \\ r_1 & 0 & Lp & r_4 \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

так как правая часть равна нулю, то  $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = \Delta_4 = 0$

Принимая во внимание что  $i_{1_{ce}} = \frac{\Delta_1}{\Delta}$ ,  $i_{2_{ce}} = \frac{\Delta_2}{\Delta}$  и т.д, и свободная составляющая не должна равняться нулю, то следует что  $\Delta(p) = 0$ . Порядок определителя соответствует числу уравнений составленных по первому и второму законам Киргофа, для данной схемы определитель 4<sup>го</sup> порядка. Если раскрыть определитель системы то он имеет вид:

$$p^2 r_1 LC + p(L + r_1 r_4 C) + r_4 + r_1 = 0 \quad (8)$$

В результате получили квадратное уравнение что соответствует порядку системы.

В общем случаи порядок системы определяется количеством реактивных элементов схемы после коммутации . Исключения составляют особые случаи ( емкостные контуры подключенные к одному узлу , индуктивные сечения).После раскрытия определителя характеристическое уравнение будет иметь вид полинома. Наибольшая степень полинома Р будет соответствовать порядку системы.

Рассмотрим возможности составления характеристического уравнения с использованием различных методов определения  $i_{св}$ на основе законов Киргофа с использованием электрической схемы рис.2, с целью получения определителя меньшего порядка.

Например, используя метод контурных токов запишем:

$$\begin{cases} i_{свI} \left( r_1 + \frac{1}{Cp} \right) - \frac{1}{Cp} i_{свII} = 0 \\ -\frac{1}{Cp} i_{свI} + i_{свII} \left( Lp + r_4 + \frac{1}{Cp} \right) = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Определитель данной системы имеет вид:

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} r_1 + \frac{1}{Cp} & -\frac{1}{Cp} \\ -\frac{1}{Cp} & Lp + r_4 + \frac{1}{Cp} \end{vmatrix} = 0 \quad (10)$$

После его раскрытия получаем:

$$p^2 r_1 LC + p(L + r_1 r_4 C) + r_4 + r_1 = 0 \quad (11)$$

Полученное характеристическое уравнение совпадает с полученным ранее, однако его порядок меньше ( $2^{\text{й}}$  порядок) он определяется числом независимых контуров или числу уравнений составленных по второму закону Киргофа.

Рассмотрим составление характеристического уравнения на основе метода узловых потенциалов рис.2

Потенциал точки 2 принимаем равным нулю  $\varphi_2=0$ , тогда согласно методу узловых потенциалов имеем:

$$\varphi_{1св} \left( \frac{1}{r_1} + Cp + \frac{1}{Lp} + \frac{1}{r_4} \right) = 0 \quad (12)$$

отсюда следует:

$$p^2 r_1 LC + p(L + r_1 r_4 C) + r_4 + r_1 = 0 \quad (13)$$

Данное характеристическое уравнение соответствует ранее полученным. Порядок определителя соответствует числу узлов, а также количеству уравнений составленных по первому закону Киргофа.

Правила составления характеристических уравнений для электрических схем:

1. Вычертим элементарную схему соответствующую уравнениям свободных составляющих, для получения этой схемы из исходной:

а) Ключ ставим в положение после коммутации .

б) Вместо источников питания ставим их внутреннее сопротивление.

с) Вместо емкости ставим сопротивление  $\frac{1}{Cp}$ , вместо индуктивности сопротивление  $Lp$ .

$Lp$ .

2. Составляем систему уравненийлюбым из известных методов.

3. Из системы уравнений находим определитель и приравниваем его нулю.

Вывод:

Предложенный алгоритм составления характеристических уравнений предполагает использование определителей меньшего порядка, что в значительной степени облегчает расчет и анализ системы дифференциальных уравнений описывающих состояние процесса.